

تحلیل، طراحی و ساخت آنتن بوقی TEM

محمد خلج امیرحسینی و رضا درخششده

غیریکنواخت باریک شونده^۳ استفاده شده است. در بخش ۲، میدانهای دور و منحنی تشعشعی آنتن بدست می‌آیند. در بخش ۳، سمتگرایی^۴ آنتن و نحوه بهینه شدن آن و نیز سمتگرایی بهینه برحسب فرکانس بررسی شده و پهنای باند آنتن بدست می‌آید. در بخش ۴، ضریب انعکاس آنتن و نحوه تغییرات آن برحسب فرکانس مشخص می‌شود. نهایتاً در بخش ۵، دو نمونه آنتن بوقی TEM طراحی شده و یکی از آنها توسط یک نرمافزار قوی شبیه‌سازی شده و دیگری ساخته و آزمایش می‌شود.

۲- میدانها و منحنی تشعشعی آنتن بوقی TEM

آنتن بوقی TEM یک آنتن روزنه‌ای^۵ می‌باشد که توسط یک موجبر صفحه موازی تعذیب می‌شود. برای یافتن میدانهای الکترومغناطیسی ناحیه دور یک آنتن روزنه‌ای کافیست که میدانهای الکتریکی مماسی روی سطح روزنه را بدانیم. آنتن بوقی TEM را می‌توان همانند یک موجبر صفحه موازی دانست که صفحات آن همزمان هم پهن‌تر شده و هم از یکدیگر دورتر می‌شوند. لذا می‌توان فرض نمود که میدان الکتریکی بین صفحات همانند میدانهای یک خط انتقال غیریکنواخت بصورت TEM می‌باشد. علاوه‌اگر این آنتن با فضای آزاد نیز تطبیق داده شود، میدانهای مذکور به صورت موج رونده^۶ نیز خواهد بود. شکل ۲، توزیع تقریبی میدان الکتریکی این آنتن را روی دهانه و دیواره‌های جانبی آن نشان می‌دهد. در واقع می‌توان میدانهای الکتریکی داخل آنتن را به صورت کروی و در حال حرکت به سمت دهانه آن دانست. در نتیجه، توزیع میدان روی سطح دهانه به علت اختلاف طول مسیرها غیریکنواخت بوده و دارای فاز و دامنه متفاوت در نقاط مختلف آن می‌باشد. البته با تقریب خوبی می‌توان از تغییرات دامنه میدان دهانه صرف‌نظر نمود و تنها تقریب اول تغییرات فاز را در نظر گرفت. بر همین اساس، رابطه زیر با توجه به پارامترهای شکل ۱، بیانگر میدان الکتریکی روی سطح دهانه آن می‌باشد

$$\vec{E}_a(x, y, \cdot) \approx E_o e^{-jk\left(\frac{x^2}{2R_i} + \frac{y^2}{2R_i}\right)} \hat{u}_y \quad (2)$$

که در آن $k = \omega\sqrt{\mu_r\varepsilon_r}$ عدد موج فضای آزاد می‌باشد. البته با توجه به وجود اختلاف فاز خطی در میدانهای دیواره‌های جانبی آنتن، تشعشع آنها همانند تشعشع آنتن‌های موج رونده در جهتی غیر از راستای آنها خواهد بود. علاوه بر این، بین راستای دیواره‌های جانبی و راستای اصلی این آنتن، اختلاف زاویه ϕ وجود دارد. بنابراین تشعشع میدانهای دیواره‌های جانبی آنتن، از راستای اصلی آنتن (روبوی آنتن) دور بوده و ضمناً از تشعشع میدانهای هم‌فاز دهانه آنتن ضعیفتر خواهد بود. لذا با تقریب خوبی می‌توان از شعشع میدانهای دیواره‌های جانبی صرف‌نظر نمود و تنها میدانهای دهانه آنتن را در نظر گرفت. این تقریب، از پیچیدگی روابط

چکیده: در این مقاله پس از معرفی آنتن بوقی TEM به عنوان یک آنتن فوق پهن باند (UWB) به تحلیل و طراحی آن پرداخته می‌شود. ابتدا میدانهای ناحیه دور، منحنی‌های تشعشعی، سمتگرایی و پهنای باند تشعشعی این آنتن بدست آمدند. سپس با استفاده از رفتار خط انتقالی آنتن، امپانس مشخصه و ضریب انعکاس وردی آن برحسب فرکانس ارائه شدند. در ادامه با توجه به روابط حاصله برای این آنتن، یک روش طراحی بهینه برای آن ارائه شده و بر همین اساس دو آنتن طراحی شده‌اند. در خاتمه با استفاده از شبیه‌سازی یا ساخت و آزمایش آنتن‌های طراحی شده، صحت روابط حاصله تأیید شدند.

کلید واژه: آنتن بوقی TEM، آنتن فوق پهن باند، منحنی تشعشعی، مدل خط انتقالی باریک شونده، طراحی و ساخت.

۱- مقدمه

آنتن بوقی TEM یک آنتن فوق پهن باند^۷ است و می‌تواند برای ارسال و دریافت پالسهای باریک با عرض چند صد پیکوثانیه به کار رود و کاربردهای زیادی از جمله به عنوان آنتن رادارهای نفوذ‌کننده زمینی^۸ دارد. این آنتن در واقع از یک خط انتقال "دو صفحه موازی" تشکیل شده است به طوریکه پهنای صفحات و فاصله آنها از یکدیگر به تدریج و بصورت خطی زیاد می‌شوند. بنابراین چون این آنتن می‌تواند امواج TEM منتشر کند آن را آنتن بوقی TEM می‌گویند. از طرف دیگر می‌توان تصور نمود که آنتن بوقی TEM یک آنتن روزنه‌ای با ابعاد $A \times B$ است که توسط یک موجبر صفحه موازی تغذیه می‌شود. شکل ۱، ساختار کلی این آنتن را نشان می‌دهد. طول فیزیکی این آنتن عبارتست از

$$R = R_E = R_H \quad (1)$$

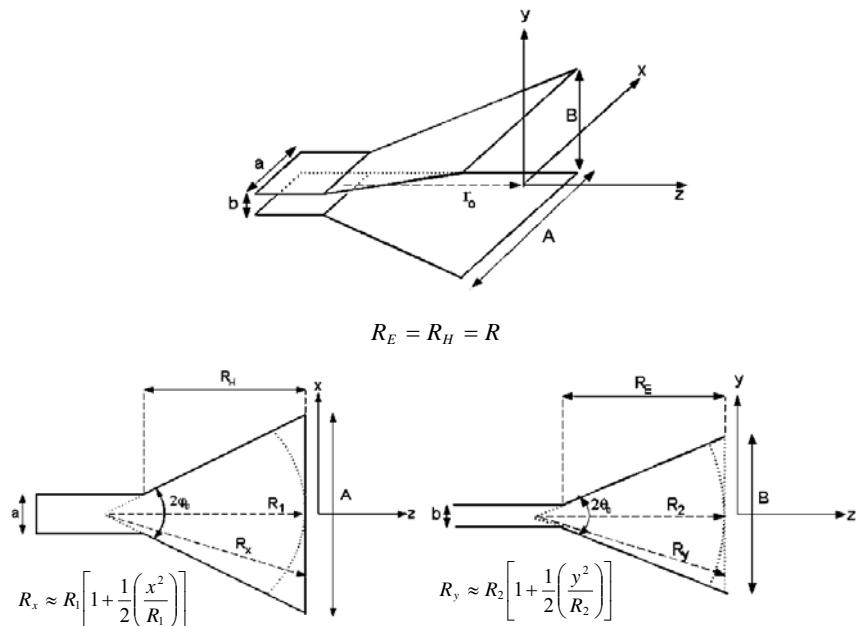
تاكونون گزارش‌هایی در مورد چگونگی استفاده از این آنتن‌ها و نیز خصوصیات آنها ارائه شده است [۱] تا [۴]. از جمله خصوصیات ذکر شده برای این آنتن‌ها پهنای باند زیاد آنها $f_U/f_L \geq 2$ می‌باشد. البته اکثر این گزارشها حاصل کارهای عملی و اندازه‌گیری می‌باشند و کمتر حاوی تحلیل و بیویژه طراحی تئوریک این آنتن‌ها هستند. در این مقاله سعی شده است تا روابطی کامل و در عین حال ساده برای تحلیل و طراحی این آنتن‌ها ارائه شود. برای تحلیل منحنی تشعشعی و بهره از تحلیل آنتن‌های روزنه‌ای و برای تحلیل ضریب انعکاس وردی از مبحث خطوط انتقال

این مقاله در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ دریافت و در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۸۳ بازنگری شد.

محمد خلج امیرحسینی، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک تهران کدپستی ۱۶۸۴۴ (email: khalaja@iust.ac.ir) رضا درخششده، دانشکده مهندسی برق، مخابرات، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک تهران کدپستی ۱۶۸۴۴

- 4. Tapered Transmission Lines
- 5. Directivity
- 6. Aperture Antenna
- 7. Traveling Wave

- 1. TEM Horn
- 2. Ultra Wide Band Antenna
- 3. Ground Penetrating Radars



شکل ۱: آتن بوقی TEM، ساختار سه بعدی و دو دید از بالا و کنار آن.

شکل ۲: توزیع تقریبی میدان الکتریکی در آتن بوقی TEM، (الف) روی دیوارهای جانبی آتن، (ب) روی سطح دهانه آتن. که در آن I_1 و I_2 توابعی بدین صورت هستند.

$$I_1(\theta, \varphi) = e^{j\frac{\pi R_\gamma}{\lambda} v^\gamma} [C(m_1) - jS(m_1) - C(n_1) + jS(n_1)] \quad (6)$$

$$I_2(\theta, \varphi) = e^{j\frac{\pi R_\gamma}{\lambda} v^\gamma} [C(m_2) - jS(m_2) - C(n_2) + jS(n_2)]$$

در رابطه (۶)،

$$m_1 = \frac{1}{\sqrt{\lambda R_1}} (A - \gamma R_1 \sin \theta \cos \varphi)$$

$$m_2 = \frac{1}{\sqrt{\lambda R_2}} (B - \gamma R_2 \sin \theta \sin \varphi) \quad (7)$$

$$n_1 = \frac{-1}{\sqrt{\lambda R_1}} (A + \gamma R_1 \sin \theta \cos \varphi)$$

$$n_2 = \frac{-1}{\sqrt{\lambda R_2}} (B + \gamma R_2 \sin \theta \sin \varphi)$$

و $C(x)$ و $S(x)$ نیز انتگرالهای فرnel^۲ به شرح زیر هستند.

$$C(x) = \int_{-\infty}^x \cos\left(\frac{\pi x^\gamma}{\gamma}\right) dx \quad (8)$$

$$S(x) = \int_{-\infty}^x \sin\left(\frac{\pi x^\gamma}{\gamma}\right) dx$$

مریوط به تحلیل و بویژه طراحی این آتن می‌کاهد. بعلاوه با به کارگیری جاذبهای مایکروویو، می‌توان تشعشع میدانهای دیوارهای جانبی را تا حد زیادی از بین برداشت.

با استفاده از میدان الکتریکی دهانه آتن، (۲)، میدانهای ناحیه دور توسط روش هویگنس^۱ چنین خواهد بود [۵]

$$E_\theta = jk \frac{e^{-jkr}}{4\pi r} (1 + \cos \theta) P_y \sin \varphi \quad (3)$$

$$E_\varphi = jk \frac{e^{-jkr}}{4\pi r} (1 + \cos \theta) P_y \cos \varphi$$

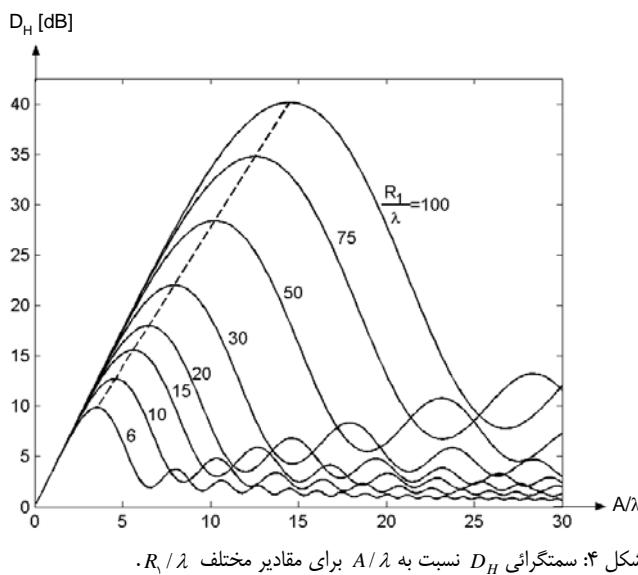
که در آن

$$P_y = \int_{-A/\gamma}^{+A/\gamma} \int_{-B/\gamma}^{+B/\gamma} E_{ay} \exp(jk(x \sin \theta \cos \varphi + y \sin \theta \sin \varphi)) dy dx \quad (4)$$

با انجام چند عملیات ریاضی ساده، نهایتاً میدانهای ناحیه دور به صورت زیر بدست می‌آیند.

$$E_\theta = jE_o \frac{e^{-j\beta r}}{4\pi r} \sqrt{R_1 R_2} (1 + \cos \theta) \cdot \sin \varphi \cdot I_1(\theta, \varphi) \cdot I_2(\theta, \varphi) \quad (5)$$

$$E_\varphi = jE_o \frac{e^{-j\beta r}}{4\pi r} \sqrt{R_1 R_2} (1 + \cos \theta) \cdot \cos \varphi \cdot I_1(\theta, \varphi) \cdot I_2(\theta, \varphi)$$

شکل ۴: سمتگرایی D_H نسبت به A/λ برای مقادیر مختلف R_1/λ .

$$q_1 = \frac{A}{\sqrt{2\lambda R_1}} \quad (12)$$

$$q_2 = \frac{B}{\sqrt{2\lambda R_2}}$$

رابطه سمتگرایی (۱۱) را می‌توان بصورت $D = D_H D_E$ نوشت که در آن D_H و D_E دو سمتگرایی مستقل از یکدیگر مربوط به صفحات H-plane و E-plane می‌باشند. شکل ۴، یکی از این سمتگراییها، D_E را بر حسب A/λ و برای چند R_1/λ نشان می‌دهد. با توجه به این شکل (منحنی خطچین) می‌توان دید که حداکثر بهره برای ابعاد محدود آنتن، بازه مقادیر بهینه زیر بدست می‌آید.

$$A = \sqrt{2\lambda R_1} \quad (13)$$

$$B = \sqrt{2\lambda R_2}$$

با توجه به (۱۱)، سمتگرایی بهینه آنتن بوقی TEM به ازای $q_1 = q_2 = 1$ (یا $t_1 = t_2 = 1/4$) بدست می‌آید که با جایگذاری در آن، حداکثر سمتگرایی آنتن بهینه چنین خواهد شد.

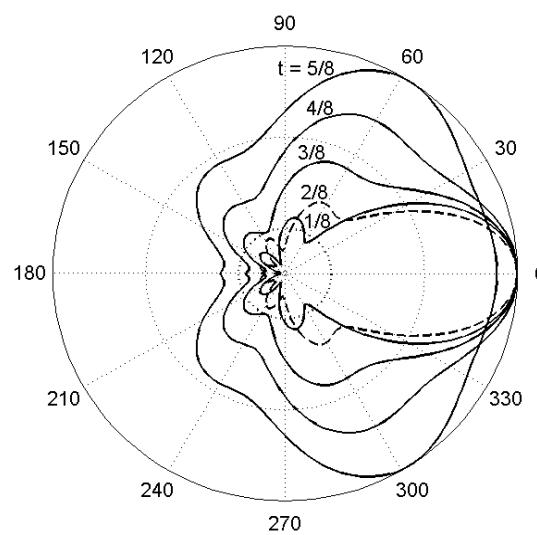
$$D_{\max} = 4\pi \frac{AB}{\lambda^2} \approx 1 \frac{AB}{\lambda^2} \quad (14)$$

در صورتیکه آنتن برای فرکانس f طراحی شده باشد، آنگاه با جایگزینی (۱۳) بازه f در (۱۲) بازه f متغیر، مقادیر q_1 و q_2 برابر با $\sqrt{f/f_c}$ خواهند شد و در نتیجه با توجه به (۱۱) و (۱۴)، مقدار سمتگرایی بهینه بر حسب فرکانس بدست خواهد آمد.

$$D_{opt} = 4\pi \frac{AB}{\lambda^2} \left[C^2 \left(\sqrt{\frac{f}{f_c}} \right) + S^2 \left(\sqrt{\frac{f}{f_c}} \right) \right]^2 \quad (15)$$

$$= 1/56 \left[C^2 \left(\sqrt{\frac{f}{f_c}} \right) + S^2 \left(\sqrt{\frac{f}{f_c}} \right) \right]^2 D_{\max}$$

شکل ۵، تابعیت فرکانسی سمتگرایی بهینه را نشان می‌دهد. از این شکل می‌توان در مورد پهنهای باند بهره آنتن بوقی TEM چنین نتیجه گرفت.

شکل ۳: منحنی تشعشعی نرمالیزه E-plane یا H-plane به ازاء t های مختلف.

منحنی تشعشعی صفحه xz (H-plane) $\varphi = 0^\circ, \pi$ و منحنی تشعشعی صفحه yz (E-plane) $\varphi = \pi/2, 3\pi/2$ در رابطه (۵) حاصل می‌شود. بنابراین منحنیهای نرمالیزه چنین خواهند شد.

$$F_E(\theta) = \frac{(1 + \cos \theta)}{2} \cdot \frac{I_r(\theta, \varphi = 90^\circ)}{I_r(\theta = 0^\circ, \varphi = 90^\circ)} \quad (9)$$

$$F_H(\theta) = \frac{(1 + \cos \theta)}{2} \cdot \frac{I_r(\theta, \varphi = 0^\circ)}{I_r(\theta = 0^\circ, \varphi = 0^\circ)}$$

با توجه به (۹) دیده می‌شود که منحنیهای نرمالیزه شده $F_E(\theta)$ و $F_H(\theta)$ مشابه یکدیگر هستند با این توضیح که منحنی تشعشعی H-plane به پهنهای صفحات (A) و منحنی تشعشعی (A) به فاصله بین صفحات (B) بستگی دارد. این تشابه منحنیها به علت تشابه دامنه و اختلاف فاز ایجاد شده روی سطح روزنۀ در هر دو جهت x و y می‌باشد. شکل ۳، منحنیهای تشعشعی نرمالیزه شده را به ازاء چند "حداکثر اختلاف فاز نسبی" $t_r = \frac{1}{\lambda} \frac{B^2}{R_1^2}$ ؛ $t_r = \frac{1}{\lambda} \frac{B^2}{R_2^2}$ نشان می‌دهد. از ضریب $(1 + \cos \theta)/2$ در این شکل صرفنظر شده است. همانطور که در بخش بعدی خواهیم دید، منحنی تشعشعی بهینه بازه $t_1, t_2 = 0/25$ حاصل می‌شود که در شکل ۳ بصورت نقطه‌چین آمده است.

۳- سمتگرایی آنتن بوقی TEM

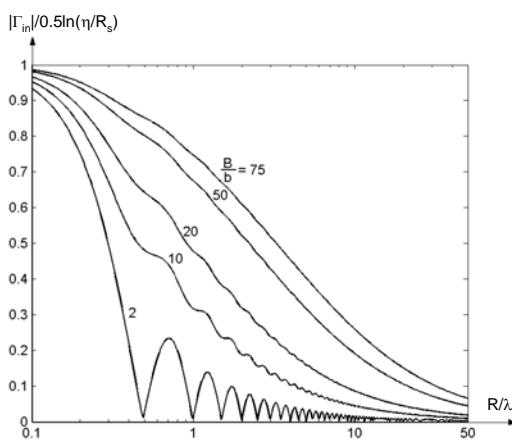
سمتگرایی یک آنتن روزنایی را می‌توان از رابطه زیر بدست آورد [۵].

$$D = \frac{4\pi}{\lambda^2} \cdot \frac{\left| \int_s \vec{E}_a ds \right|^2}{\int_s |\vec{E}_a|^2 ds} \quad (10)$$

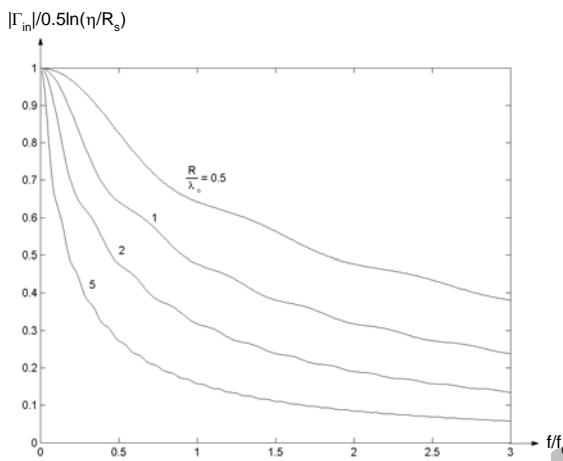
با استفاده از جایگذاری میدان الکتریکی روزنۀ \vec{E}_a از (۲) در (۱۰) و پس از انجام چند عملیات ریاضی مربوط به انتگرالگیری، رابطه زیر حاصل می‌شود.

$$D = 4\pi \frac{AB}{\lambda^2} \cdot \frac{[C^2(q_1) + S^2(q_1)][C^2(q_2) + S^2(q_2)]}{q_1^2 q_2^2} \quad (11)$$

که در آن q_1 و q_2 چنین تعریف شده‌اند.



شکل ۶: ضریب انعکاس آتن بوقی TEM بر حسب طول نسبی آن.



شکل ۷: ضریب انعکاس آتن بر حسب فرکانس نسبی

با جایگزینی (۲۰) در (۲۰)، انتگرال زیر حاصل می‌شود.

$$\Gamma_{in} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon}} \int e^{-j\gamma kz} \frac{(Ba - bA)R}{((B-b)z + Rb)((A-a)z + Ra)} dz \quad (21)$$

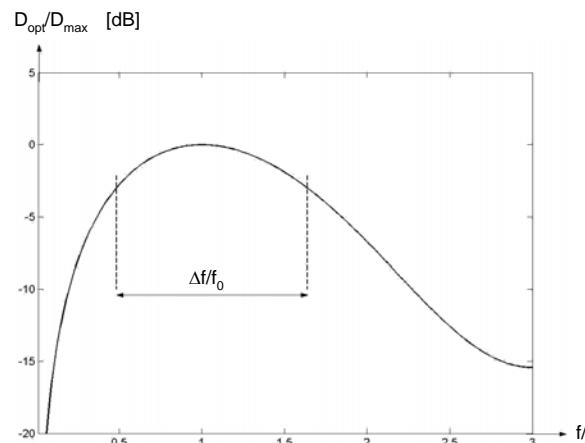
این انتگرال با روش‌های معمولی قابل حل نیست ولی می‌توان آنرا بر حسب تابع انتگرال نمائی نوشت.

$$\begin{aligned} \Gamma_{in} &= \frac{1}{\sqrt{\epsilon}} e^{j\gamma kR \frac{1}{B/b-1}} \left[E_i \left(j\gamma kR \frac{1}{B/b-1} \right) - E_i \left(j\gamma kR \frac{B/b}{B/b-1} \right) \right] \\ &\quad - \frac{1}{\sqrt{\epsilon}} e^{j\gamma kR \frac{1}{A/a-1}} \left[E_i \left(j\gamma kR \frac{1}{A/a-1} \right) - E_i \left(j\gamma kR \frac{A/a}{A/a-1} \right) \right] \end{aligned} \quad (22)$$

که در آن تابع انتگرال نمائی به صورت زیر معروف است.

$$E_i(x) = \int_1^{\infty} \frac{e^{-xt}}{t} dt \quad (23)$$

در شکل ۶ ضریب انعکاس یک آتن بوقی TEM که ورودی آن با کابل $R_S = 100 \Omega$ و دهانه آن با فضای آزاد تطبیق شده‌اند، بر حسب طول نسبی آتن و بازاء چند نسبت B/b رسم شده است. شکل ۷ نیز ضریب انعکاس همین آتن را با $B/b = 20$ بر حسب فرکانس نشان می‌دهد.



شکل ۸: سمتگرایی بهینه نسبی بر حسب فرکانس نسبی.

$$\begin{aligned} \frac{\Delta f}{f_o} &= \frac{f_H - f_L}{f_o} = 1/637 - 1/483 = 1/154 \\ \frac{f_H}{f_L} &= 3/39 \end{aligned} \quad (16)$$

۴- ضریب انعکاس آتن بوقی TEM

یکی از مهمترین ویژگی‌های آتن بوقی TEM، رفتار خط انتقالی آن است. همانطور که قبلاً گفته شد آتن بوقی TEM در واقع یک خط انتقال صفحه موازی است که پهنا و فاصله بین صفحات آن به تدریج زیاد می‌شود. در این صورت می‌توان با تقریب خوبی از تئوری خطوط انتقال برای بدست آوردن امپدانس مشخصه این آتن استفاده کرد [۶]. برای یک خط انتقال صفحه موازی مشکل از صفحاتی با پهنای W و با فاصله d از یکدیگر، امپدانس مشخصه از رابطه $Z = (d/W)\eta$ به دست می‌آید. بنابراین با توجه به شکل ۱، رابطه زیر را برای امپدانس مشخصه آتن بوقی TEM خواهیم داشت (با فرض مبدأ مختصات در ابتدای آتن).

$$Z(z) = \frac{R-b}{A-a} \frac{z+b}{z+a} \eta = \frac{(B-b)z + Rb}{(A-a)z + Ra} \eta \quad (17)$$

که در آن $R = R_E = R_H$ می‌باشد. از رابطه فوق امپدانس مشخصه ابتدا و انتهای چنین خواهد بود.

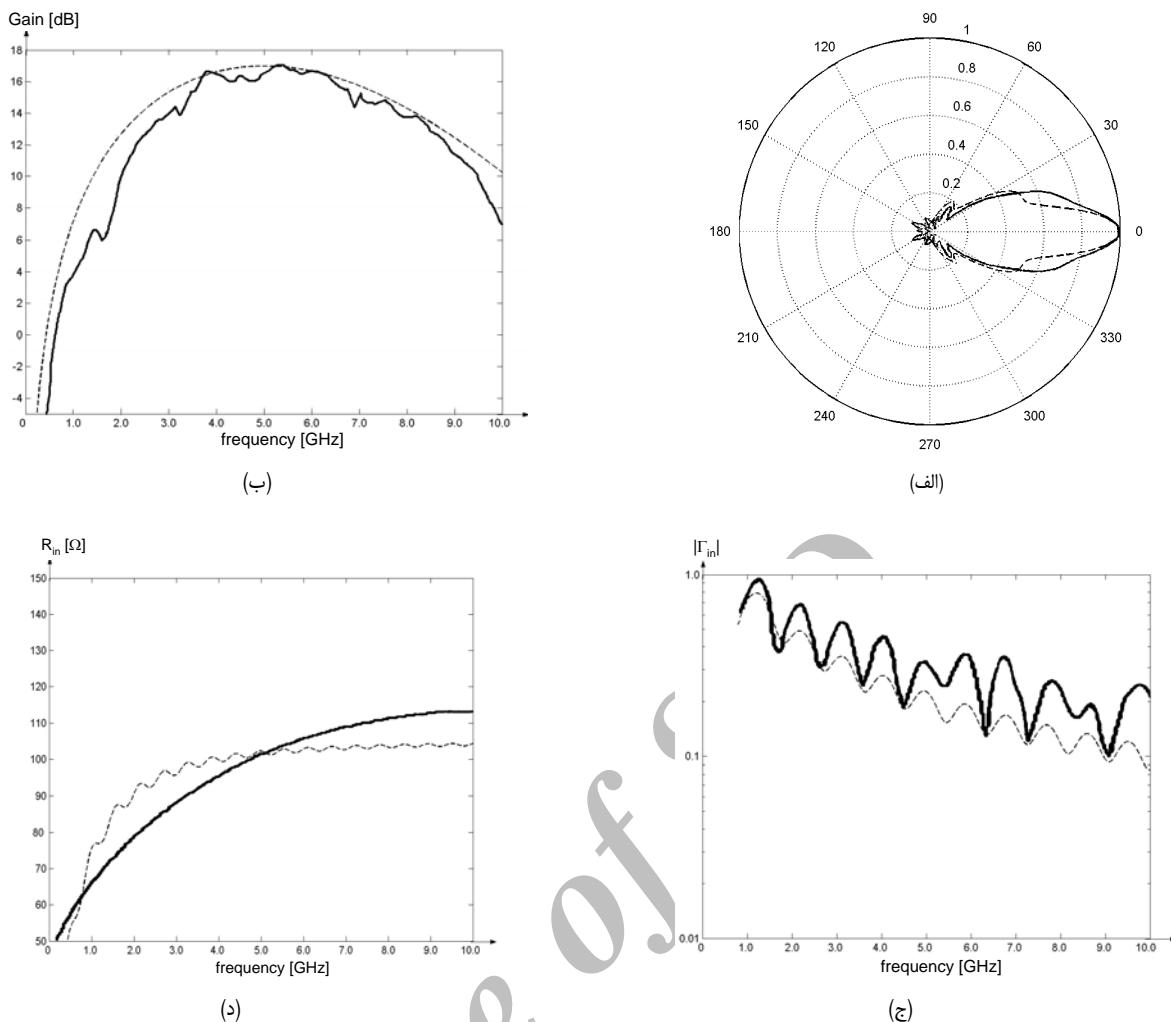
$$\begin{aligned} Z(\cdot) &= \frac{b}{a} \eta \\ Z(R) &= \frac{B}{A} \eta \end{aligned} \quad (18)$$

بنابراین برای تطبیق دهانه آتن با فضای آزاد و تطبیق ورودی آن با مقاومت تغذیه R_S می‌بایستی روابط زیر برقرار شوند.

$$\begin{aligned} B &= A \\ \frac{b}{a} \eta &= R_S \end{aligned} \quad (19)$$

ضریب انعکاس آتن بعنوان یک خط انتقال غیربکنوخت با تغییرات تدریجی عبارت است از [۶]

$$\Gamma_{in} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon}} \int_1^R e^{-j\gamma kz} \frac{d}{dz} [\ln(Z(z)/R_s)] dz \quad (20)$$



شکل ۸: نتایج حاصل از شبیه‌سازی (خطوط پیوسته) و تئوری (خطوط مقطع) برای آنتن بوقی TEM طراحی شده، (الف) منحنی تشعشعی در فرکانس ۰/۵-۰/۵ GHz، (ب) بهره بر حسب فرکانس، (ج) ضریب انعکاس بر حسب فرکانس، (د) مقاومت ورودی بر حسب فرکانس.

انتخابی و کمی بزرگتر از یک است تا سه رابطه (۲۶)-(۲۹) با توجه به (۲۴) جواب داشته باشد. در اینصورت با ادغام سه رابطه (۲۴)، (۲۷)، (۲۸)، رابطه زیر حاصل می‌شود.

$$a = \frac{K-1}{K-R_S/\eta} A \quad ; \quad K > 1 \quad (29)$$

البته می‌توان K را یک انتخاب نمود ولی بین صفحات آنتن از عایق با ضریب دی‌الکتریک ϵ_r استفاده نمود که در اینصورت $B = \sqrt{\epsilon_r} A$ خواهد شد.

در اینجا یک آنتن بوقی TEM با بهره ۱۷ dB در فرکانس ۰/۵-۰/۵ GHz و با خط تعذیه $R_S = 100 \Omega$ طراحی می‌کنیم. با استفاده از (۲۸)-(۲۹) و با انتخاب $K = 1/1$ ابعاد آنتن چنین بدست می‌آید.

$$A = ۱۵/۱ \text{ cm}$$

$$B = ۱۵/۱ \text{ cm}$$

$$a = ۱/۷۹ \text{ cm}$$

$$b = ۰/۴۷ \text{ cm}$$

$$R = ۱۶/۵۲ \text{ cm}$$

جهت اطمینان از طراحی انجام شده و نیز بررسی صحت روابط بدست آمده در این مقاله برای تحلیل آنتهای بوقی TEM، آنتن طراحی شده فوق بوسیله نرم‌افزار HFSS® در محدوده فرکانسی ۲۰۰ MHz تا ۱۰ GHz شبیه‌سازی شد. شکل ۸ نتایج حاصل از شبیه‌سازی آنتن را به

۵- طراحی، شبیه‌سازی و ساخت آنتن بوقی TEM

هدف از طراحی یک آنتن بوقی TEM بدست آوردن ابعاد ابتدائی (a) و انتهایی (A و B) و طول (R) آن جهت کار در فرکانسی مشخص و با بهره‌ای معین و همچنین با امپدانس ورودی R_S می‌باشد. این طراحی بهتر است بصورت بهینه انجام شود تا ابعاد آنتن طراحی شده حداقل شود. روابط موجود بین ابعاد آنتن بهینه و تطبیق شده در ابتداء و انتهای آن با توجه به (۱)، (۱۳)، (۱۴) و (۱۹) و نیز شکل آنتن عبارتند از

$$A = B \quad (24)$$

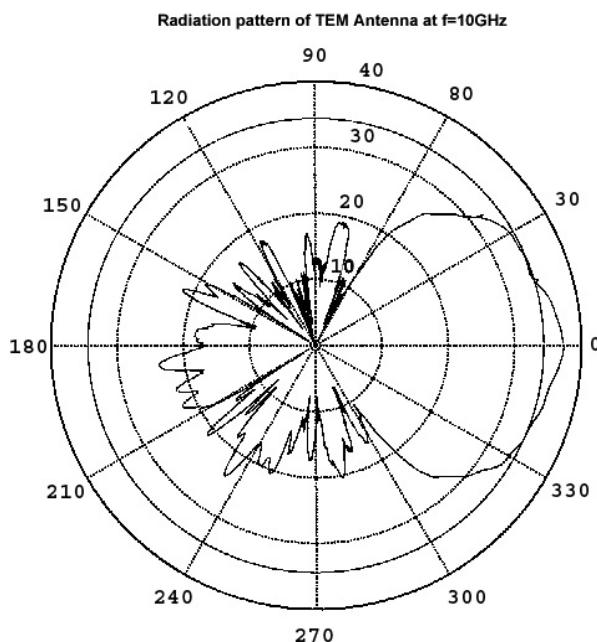
$$D_{\max} \cong \lambda \frac{A \cdot B}{\lambda} \quad (25)$$

$$\frac{a}{b} = \frac{\eta}{R_S} \quad (26)$$

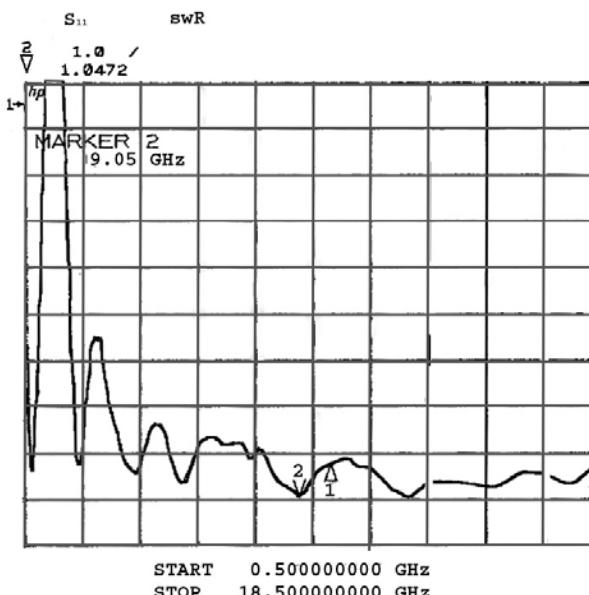
$$R = R_H = \frac{A-a}{A} K R_{opt} = \frac{A-a}{A} \frac{A^\gamma}{2\lambda} K \quad (27)$$

$$R = R_E = \frac{B-b}{B} R_{opt} = \frac{B-b}{B} \frac{B^\gamma}{2\lambda} \quad (28)$$

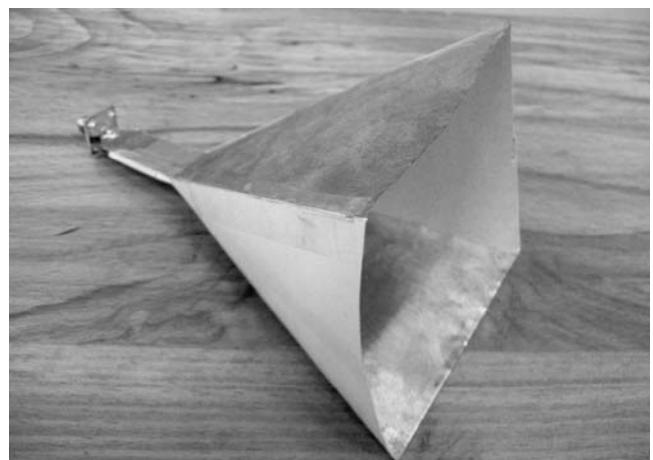
از دو رابطه (۲۴) و (۲۵)، مقادیر A و B و سپس توسط سه رابطه (۲۸)-(۲۶) مقادیر a ، b و R به دست می‌آیند. ضریب K عددی



شکل ۱۰: منحنی تشعشعی E-plane اندازه‌گیری شده در فرکانس ۱۰ GHz.



شکل ۱۱: SWR اندازه‌گیری شده بر حسب فرکانس.



شکل ۹: تصویر آتن بوقی TEM ساخته شده.

همراه نتایج حاصل از روابط تئوری (توسط نرم‌افزار MATLAB[®]) نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌شود هم نتایج بدست آمده از شبیه‌سازی با تقریب خوبی با نتایج تئوریک مطابقت دارند و هم آتن طراحی شده دارای خصوصیات مورد نظر می‌باشد. پهن‌تر بودن کناره‌های منحنی تشعشعی حاصل از شبیه‌سازی نسبت به منحنی تشعشعی حاصل از روابط تئوری و نیز اختلافهای موجود بین ضرائب انعکاس می‌تواند ناشی از تشعشع میدانهای دیواره‌های جانبی آتن باشد که در تئوری از آنها صرف نظر شده بود.

در یک طرح دیگر یک آتن بوقی TEM با بهره ۱۷ dB با بهره کار در فرکانس ۱۰ GHz و با خط تقدیم $R_S = ۵۰ \Omega$ طراحی می‌کنیم. با استفاده از روابط (۲۴)–(۲۸) و با انتخاب $K = ۱/۲۲$ ابعاد آتن چنین بدست می‌آیند.

$$A = ۷/۵ \text{ cm}$$

$$B = ۷/۵ \text{ cm}$$

$$a = ۰/۱۵ \text{ mm}$$

$$b = ۰/۲۰ \text{ mm}$$

$$R = ۹/۱۳ \text{ mm}$$

آتن طراحی شده فوق با استفاده از دو ورق نازک مسی و دو ورق نازک کاغذی و یک کانکتور نوع SMA بسادگی ساخته شد که تصویر آن در شکل ۹ آورده شده است. شکل ۱۰ منحنی تشعشعی H-plane (صفحه افقی) آتن را در فرکانس اندازه‌گیری ۱۰ GHz نشان می‌دهد. بهره آتن هم با استفاده از اندازه‌گیری زوایای نیم-توان (θ_E و θ_H) منحنی تشعشعی و رابطه تقریبی

$$D_{\max} \equiv \frac{۲۶...}{\theta_E \theta_H} \quad (۳۰)$$

حدود ۱۵ dB به دست آمد. کمتر بودن بهره عملی آتن می‌تواند ناشی از تقریب در (۳۰) و نیز صرفنظر نمودن از تشعشع میدانهای کناری آتن باشد. همچنین نسبت امواج ساکن SWR در محدوده فرکانسی ۵/۱۸–۱۸/۵ GHz توسط دستگاه آنالایزر مدار^{۱۰} اندازه‌گیری شد که نتایج در شکل ۱۱ آمده است. همانطور که دیده می‌شود مقدار SWR با افزایش فرکانس کاهش می‌یابد و از فرکانس حدود ۷/۵ GHz به بعد به کمتر از ۱:۲ می‌رسد. البته اگر فرکانس خیلی زیادتر شود انتظار می‌رود SWR افزایش یابد که علت آن پاسخ فرکانسی محدود کانکتور SMA و نیز کاهش دقت تقریب خط انتقال برای آتن می‌باشد.

در این مقاله به بررسی میدانهای تشعشعی ناحیه دور و منحنیهای تشعشعی آتن بوقی TEM پرداخته شد و سمتگرایی بهینه و پهنای باند بهره آن بدست آمد. همچنین با استفاده از مدل خط انتقالی، ضریب انعکاس ورودی آتن بر حسب فرکانس بدست آمد. آتن بوقی TEM دارای یک طراحی بهینه می‌باشد که طبق آن راندمان دهانه آتن %۶۴ با پهنای باند نسبی ۱۱۵/۴٪ خواهد بود. همچنین این آتن از نظر میزان تطبیق در ورودی، همانند یک فیلتر بالاگذر می‌باشد که با افزایش طول آتن کارایی بهتری می‌یابد. بر اساس روابط حاصله برای تحلیل آنتهای بوقی TEM یک روش برای طراحی بهینه آنها ارائه شده است. صحت روابط حاصله توسط شبیه‌سازی یک آتن و نیز ساخت و آزمایش آتنی دیگر تأیید گردید.

- [5] Warren L. Stutzman and Gary A. Thiele, *Antenna Theory and Design*, John Wiley and Sons, NewYork, 1981, Chapters 6 and 8.
- [6] Robert E. Collin, *Foundations for Microwave Engineering*, McGraw-Hill, NewYork, 1966, Chapter 5.

محمد خلج امیرحسینی تحصیلات خود را در مقاطعه کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی برق-مخابرات به ترتیب در سالهای ۱۳۷۰، ۱۳۷۳ و ۱۳۷۷ از دانشگاه علم و صنعت ایران به پایان رسانده است و هم اکنون عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق همین دانشگاه می‌باشد. زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه ایشان عبارتند از: الکترومغناطیس، آنتن، مایکروویو و مدارهای فرکانس بالا.

رضا درخشندۀ در سال ۱۳۵۸ در شهر تهران بدینی آمد. در سال ۱۳۸۲ وی موفق به اخذ مرک کارشناسی مهندسی برق-مخابرات از دانشگاه علم و صنعت ایران گردید.

۷- قدردانی

بدینوسیله از زحمات متخصصین آزمایشگاه آنتن دانشگاه مالک اشتراحت آزمایش آنتن ساخته شده قدردانی می‌شود.

مراجع

- [1] L. -C. T. Chang and W. D. Burnside, "An ultrawide-bandwidth tapered resistive TEM horn antenna", *IEEE Trans. on Antennas and Propagation*, vol. 48, no. 12, pp. 1848-1857, Dec. 2000.
- [2] K. L. Schlager and G. S. Smith, "TEM Horn antenna for pulse radiation: an improved design", *Microwave and Optical Technology Letters*, vol. 12, pp. 86-90, Jun. 1996.
- [3] M. Kanda, "Transients in a resistively loaded linear antenna which compared with those in a conical antenna and a TEM horn", *IEEE Trans. on Antennas and Propagation*, vol. 28, no. 1, pp. 132-136, Jan. 1980.
- [4] A. G. Yarovoy, A. D. Schukin, and L. P. Ligthart, "Development of dielectric filled TEM-horn", in *Proc. Millennium Conference on Antennas and Propagation*, pp. 1-4, Davos, Switzerland, Apr. 2000.